

課題番号 : F-17-IT-0002
利用形態 : 技術代行
利用課題名(日本語) : 低損失 Ga₂O₃ トレンチ MOS 型ショットキーバリアダイオードの開発
Program Title (English) : Development of Low-Loss Ga₂O₃ Trench MOS-Type Schottky Barrier Diodes
利用者名(日本語) : 佐々木公平
Username (English) : K. Sasaki
所属名(日本語) : 株式会社ノバルクリスタルテクノロジー
Affiliation (English) : Novel Crystal Technology, Inc.
キーワード/Keyword : 酸化ガリウム, Ga₂O₃, trench MOS, ショットキー, 成膜・膜堆積

1. 概要 (Summary)

Ga₂O₃ は、材料物性および量産性の点から、次世代の低損失高耐圧パワーデバイス用材料として開発が進められている。本研究では、トレンチ MOS 型 Ga₂O₃ ショットキーバリアダイオード(MOSSBD)の性能向上を目的にプロセス技術およびデバイス構造を改良した。その結果、市販 SiC SBD を超える低損失性能を有する Ga₂O₃ MOSSBD の動作実証に成功した。

2. 実験 (Experimental)

【利用した主な装置】

- ・ 原子層堆積装置

【実験方法】

Ga₂O₃ 基板上に Si ドープ Ga₂O₃ 膜を形成した。膜の表面に、NIMS 微細加工 PF のドライエッチング装置でトレンチ構造を形成した。トレンチ内部には東工大ナノテク PF の原子層堆積装置を用いて HfO₂ 膜を形成した。その後、アノード電極とカソード電極を形成し、電気特性を早稲田大学ナノテク PF の測定装置にて評価した。

3. 結果と考察 (Results and Discussion)

試作したデバイスの順方向特性と逆方向特性を評価したところ、Ga₂O₃ MOSSBD の逆方向特性は市販 SiC SBD と同等の低いリークレベルを示すことがわかった。本結果は、当初の狙い通りトレンチ内部へ形成した HfO₂ 膜によってリーク電流を抑制できていることを示している。図に試作したデバイスと市販 SiC SBD の順方向特性を示す。Ga₂O₃ MOSSBD は市販 SiC SBD よりも最大で 40% 低損失で動作している。プロセスおよびデバイス構造の改良により、SiC デバイスを超える性能を実証することに世界で初めて成功した。

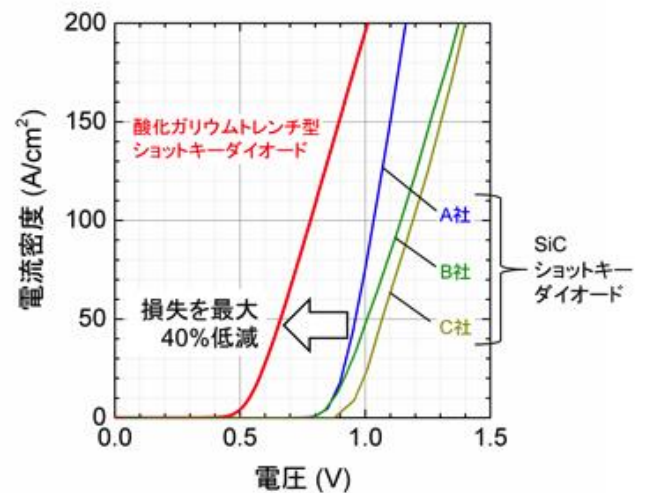


Fig. Forward characteristics of Ga₂O₃ MOSSBD and SiC SBDs.

4. その他・特記事項 (Others)

他機関の利用: NIMS ナノテク PF(F-17-NM-0001), 早稲田大学(F-17-WS0011, 0048)も利用した。

5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation)

- (1) K. Sasaki *et al.*, IEEE Electron Device Lett., Vol. 38 (2017) p.p.783-785.
- (2) K. Sasaki *et al.*, Appl. Phys. Express, Vol. 10 (2017) pp.124201.
- (3) K. Sasaki *et al.*, Device Research Conference, 26/June/2017.

6. 関連特許 (Patent)

特許出願済み